

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 2012 г.

Техническая политика

3 Применение беспроводных систем мониторинга и связи в энергетике. *Гречихин В. А., Замолодчиков В. Н., Смольский С. М.* (на английском языке)

4 6 Мировые тенденции развития микроэлектроники и место Республики Беларусь в этом процессе. *Белоус А. И., Пилипенко В. А., Турцевич А. С., Шведов С. В.*

Система единого генератора. *Басюк О. П.*

Новые компоненты для электронной аппаратуры

1 Реальная и предельная чувствительность некоторых приемников излучения ТГц/суб-ТГц-диапазонов. *Шевчик-Шекера А. В.*

4 Электрические соединители для поверхностного непаяного монтажа. *Ефименко А. А.* (на английском языке)

Электронные средства: исследования, разработки

1 Система искусственного интеллекта для технической диагностики фотошаблонов. *Козина Ю. Ю., Козин А. А.*

1 КИХ-фильтры с независимым управлением фазочастотной характеристикой. *Иванов В. В., Шакурский В. К., Шакурский М. В.*

1 Импедансный анализатор для идентификации марок водно-спиртовых напитков. *Кукла А. Л., Павлюченко А. С., Майстренко А. С., Мамыкин А. В.*

2 Полуактивный радиочастотный датчик контроля расхода электроэнергии. *Лищинская Л. Б., Лазарев А. А., Барабан М. В., Филинчук Н. А.*

2 Подавление синхронной помехи в ЯКР с модуляцией Зеемана. *Политанский Л. Ф., Самила А. П., Хандожко В. А.*

4 Формализованные показатели для оценки качества радиотехнических систем охраны периметров объектов. *Колесник К. В., Кипенский А. В., Мачехин Ю. П., Чурюмов Г. И.*

5 Многоуровневые платы с толсто пленочной полимерной изоляцией. *Спирин В. Г.*

Светодиодные показывающие электроизмерительные устройства на многопороговых компараторах. *Оборский Г. А., Ковальков В. И., Тухенко В. Н., Слободяник П. Т.*

Тепловая математическая модель полупроводниковых приборов при измерении ВАХ импульс-

ным способом. *Ермоленко Е. А., Бондаренко А. Ф., Баранов А. Н.* 5

3 Твердотельный импульсный микроволновой мост для спектрометров электронного спинового эха 8-мм диапазона длин волн. *Калабухова Е. Н., Олейник В. В., Савченко Д. В., Ситников А. А., Цвир А. В., Ищенко М. Г.* 6

СВЧ-техника

4 6 Особенности реализации микрополосковых фильтров с кольцевыми резонаторами бегущей волны. *Глушеченко Э. Н.* 6

6 Пределы управляемости диэлектрической неоднородности, расположенной между металлическими плоскостями. *Прокопенко Ю. В.* 6

1 6 Методы формирования алгоритмов для расчета перестраиваемых коаксиальных полосовых фильтров СВЧ. *Парфилов А. А.* 6

Системы передачи и обработки сигналов

1 Непрерывная и импульсная синхронизация работы генераторов Чуа. *Элияшив О. М., Галюк С. Д., Политанский Л. Ф., Кушнир Н. Я., Танасюк В. С.* 1

1 Безындуктивные генераторы хаотических колебаний по схеме Чуа. *Элияшив О. М., Политанский Л. Ф.* 2

1 Хаотическое маскирование информационных сигналов с использованием генератора на базе системы Лю. *Иванюк П. В., Политанский Л. Ф., Политанский Р. Л., Элияшив О. М.* 3

2 Синхронизация потоков данных в многоканальных системах ЦОС с перестраиваемой структурой. *Шейк-Сейкин А. Н.* 4

Энергетическая электроника

2 Влияние толщины кремниевых пластин на характеристики многопереходных солнечных элементов с вертикальными $p-n$ -переходами. *Гниленко А. Б., Дзензерский В. А., Плаксин С. В., Погорелая Л. М.* 1

4 Оптимизация структуры многоячейкового транзисторного преобразователя. *Бондаренко Ю. В., Бондаренко А. Ф., Сафронов П. С., Сидорец В. Н.* 2

Биомедицинская электроника

5 Матричный светодиодный излучатель для фотодинамической терапии. *Денисов Н. А., Редчук А. А.* 2

Сенсоэлектроника

Компьютерная обработка изображений, полученных при помощи сенсора на базе гетероперехода CdS–Cu₂S. *Борщак В. А.*

Эффективность сбора зарядов в датчиках g-излучения с различной конфигурацией электродов. *Кондрик А. И.*

Нанокристаллы Si_{1-x}Ge_x в роли чувствительных элементов сенсора магнитного поля и температуры. *Дружинин А. А., Островский И. П., Ховерко Ю. Н., Ничкало С. И., Корецкий Р. Н.*

Высокотемпературные датчики давления с тензорезисторами на основе нитевидных кристаллов кремния. *Дружинин А. А., Кутраков А. П., Марьямова И. И.*

Функциональная микро- и нанoeлектроника

Определение радиационной стойкости ИС с помощью низкоэнергетического излучения. *Первертайло В. Л.*

Мощные излучающие диоды инфракрасного диапазона. *Коган Л. М.*

Природа переходов и механизмы генерации в лазерах на основе радиационно легированных кристаллов CdS. *Гаркавенко А. С.*

Микрополосковые электромагнитные кристаллы с низкоимпедансными неоднородностями. *Назарько А. И.*

Свойства двойных гетеропереходов p⁺-InP/n-InGaAsP/n-InP, изготовленных методом жидкофазной эпитаксии. *Вакив Н. М., Круковский С. И., Сукач А. В., Тетёркин В. В., Мрыхин И. А., Михашук Ю. С., Круковский Р. С.*

Температурные поля в растущем кристалле «солнечного кремния». *Кондрик А. И., Даценко О. А., Коетун Г. П.*

Исследование импульсных характеристик ограничителей напряжения. *Каримов А. В., Ёдгорова Д. М., Рахматов А. З., Скорняков С. Л., Петров Д. А., Абдулхаев О. А.*

Исследование температурной зависимости контактного сопротивления омических контактов к InP. *Новицкий С. В.*

Индуктивность, электрически перестраиваемая полупроводниковой структурой. *Семенов А. А., Усанов Д. А., Колокин А. А.*

Схемотехника СБИС для микроэлектронного координатно-чувствительного детектора для элементного анализа материалов. *Сидоренко В. П., Вербицкий В. Г., Прокофьев Ю. В.*

Повышение надежности диодов Шоттки при воздействии разрядов статического электричества. *Солодуха В. А., Турцевич А. С., Соловьёв Я. А., Рубцевич И. И., Керенцев А. Ф.*

Фотоэлектрические свойства гетеропереходов n-SiC/n-Si. *Семенов А. В., Козловский А. А., Пузилов В. М.*

3 Фотодиод на основе GaP с повышенной чувствительностью в коротковолновой области УФ-спектра. *Добровольский Ю. Г.*

4 Влияние распределения примеси в базе на фотоэлектрические свойства поверхностно-барьерных УФ-фотоприемников. *Бобренко Ю. Н., Комащенко В. Н., Ярошенко Н. В., Шереметова Г. И., Атнаев Б. С.*

5 Характеристики фотодиодов со структурой «собственный оксид – InSe», облученных высокоэнергетическими электронами. *Сидор О. Н., Сидор О. А., Ковалюк З. Д., Дубинко В. И.*

Обеспечение тепловых режимов

Интенсивность теплоотдачи при кипении на поверхности малого размера. *Алексеик О. С., Кравец В. Ю., Копчевская И. А.*

1 Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера. *Гершуни А. Н., Нищик А. П.*

1 Экспериментальное исследование энергетических характеристик проницаемого термоэлемента. *Черкез Р. Г., Демьянюк Д. Д.*

Технологические процессы и оборудование

Подключающее МЭМС-устройство для контроля BGA-компонентов. *Невлюдов И. Ш., Мартыняк Р. М., Палагин В. А., Слободян Б. С., Разумов-Фризюк Е. А., Жарикова И. В., Дмитриев М. И., Беляев А. С.*

2 Кинетика процессов осаждения пленок поликремния, легированного кислородом в процессе роста. *Наливайко О. Ю., Турцевич А. С.*

3 Метод оценки качества тонкопленочной платы. *Спирин В. Г.*

3 Технология создания легированных бором слоев на алмазе. *Зяблук К. Н., Митягин А. Ю., Талипов Н. Х., Чучева Г. В., Духновский М. П., Хмельницкий Р. А.*

4 Исследование качества пайки кристаллов мощных транзисторов релаксационным импеданс-спектрометром. *Турцевич А. С., Рубцевич И. И., Соловьёв Я. А., Васьяков О. С., Кононенко В. К., Нисс В. С., Керенцев А. Ф.*

5 Массоперенос при жидкофазной эпитаксии двухслойных систем. *Дранчук С. Н., Завадский В. А., Мокрицкий В. А.*

5 Получение тонких пленок Si₃N₄ при пониженном давлении на пластинах диаметром до 200 мм. *Наливайко О. Ю., Турцевич А. С.*

Материалы электроники

Повышение эффективности кремниевых солнечных элементов посредством нанопористого покрытия. *Джафаров Т. Д., Асланов Ш. С., Рагимов Ш. Х., Садыгов М. С., Набиева А. Ф., Айдин Юксел С.* (на английском языке)

2

Фотолюминесцентный метод исследования пластической деформации на границе раздела «SiO₂—Si». *Кулинич О. А., Яцунский И. Р., Ештокина Т. Ю., Брусенская Г. И., Марчук И. А.*

2

Наноконпозиты на основе опаловых матриц с кристаллическими ферротороидальными мультиферроиками. *Самойлович М. И., Ринкевич А. Б., Бовтун В., Белянин А. Ф., Нужный Д., Кемпа М., Цветков М. Ю., Клещева С. М.*

3

Влияние толщины и температуры пленок фталоцианина меди на их свойства. *Алиева Х. С.*

3

Механизм формирования межслоевых квантовых нитей в легированном цинком Bi₂Te₃. *Алиева А. П., Алескеров Ф. К., Кахраманов С. Ш., Насибова С. А., Моройдор Е. Д., Пишкин М.*

3

Широкозонные халькогенидные сцинтилляторы на основе соединений A^{II}B^{VI}. *Старжинский Н. Г., Гринёв Б. В., Рыжиков В. Д., Малюкин Ю. В., Жуков А. В., Сидлецкий О. Ц., Зеня И. М., Лалаянц А. И.*

4

Прогноз диэлектрических потерь в стеклокерамике для разных соотношений массовых долей компонентов. *Дмитриев М. В., Еримичой И. Н., Панов Л. И.*

4

Гетеропереходы, сформированные отжигом слоистых кристаллов GaSe и InSe в парах цинка. *Кудринский З. Р., Ковалюк З. Д.*

6

Стимулируемая водородом миграция атомов металлов в структурах «металл — полупроводник». *Матюшин В. М., Жавжаров Е. Л.*

6

Метрология. Стандартизация

Визуальные и оптико-электронные автоколлиматоры. *Фесенко А. В., Боровицкий В. Н.*

6

Библиография

Указатель статей, опубликованных в журнале в 2011 г.

1

РЕЦЕНЗЕНТЫ НОМЕРА

Дмитрук Николай Леонтьевич, докт. физ.-мат. наук, профессор, Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарёва НАНУ, г. Киев

Добровольский Юрий Георгиевич, канд. техн. наук, начальник научно-аналитического отдела, Научно-производственная фирма «Тензор», г. Черновцы

Иващук Анатолий Васильевич, канд. техн. наук, зам. директора научно-учебного центра «Наноэлектроника и нанотехнологии», доцент, НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев

Кондрик Александр Иванович, ведущий инженер-исследователь, ННЦ «Харьковский физико-технический институт», г. Харьков

Круковский Семен Иванович, докт. техн. наук, начальник сектора, НПП «Карат», г. Львов

Кудрик Ярослав Ярославович, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарёва НАНУ, г. Киев

Николаенко Юрий Егорович, докт. техн. наук, ведущий научный сотрудник, НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев

Рюхтин Вячеслав Васильевич, канд. техн. наук, зам. председателя правления по научной работе, ЦКБ «Ритм», г. Черновцы

Старжинский Николай Григорьевич, докт. техн. наук, ведущий научный сотрудник Института сцинтилляционных материалов НАНУ, г. Харьков

Старостенко Владимир Викторович, докт. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой, профессор, Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, г. Симферополь

Трофимов Владимир Евгеньевич, канд. тех. наук, доцент, Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса